© 2017 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 72.10.Fk, 73.23.Ad, 73.25.+i, 73.50.Bk, 73.61.At, 73.63.Bd, 81.15.Kk

### Вплив підшарів ґерманію на металізацію плівок срібла

Р. І. Бігун<sup>1</sup>, З. В. Стасюк<sup>1</sup>, О. В. Строганов<sup>1</sup>, М. Д. Бучковська<sup>1</sup>, В. М. Гаврилюх<sup>1</sup>, Я. А. Пастирський<sup>1</sup>, Д. С. Леонов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 50, 79005 Львів, Україна <sup>2</sup>Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна

В умовах надвисокого вакууму досліджено електропровідність плівок срібла, нанесених на поверхню скла та поверхню скла, попередньо покриту підшарами ґерманію різної товщини. Ультратонкі плівки ґерманію (масовою товщиною у 0,5-5 нм) пришвидшують металізацію плівок срібла та зменшують порогову товщину перколяційного переходу. Показано, що найбільші зміни кінетичних коефіцієнтів досліджуваних плівок срібла спостерігаються в діяпазоні товщин підшару ґерманію до 2 нм. Розмірні залежності питомого опору плівок пояснено у рамках сучасних модельних уявлень про розмірні ефекти.

Electronic conduction in silver films deposited on bare glass surface and glass surface predeposited with germanium underlayers under ultrahigh vacuum conditions is investigated. Ultrathin germanium underlayers (with mass thickness of 0.5-5 nm) accelerate the silver-films' metallization and reduce the threshold thickness of percolation transition. As shown, the major changes in kinetic coefficients of studied silver films are observed, if the germanium mass thickness is less than 2 nm. The resistivity-size dependences are explained within the scope of the model approximations of dimensional effects.

В условиях сверхвысокого вакуума исследована электропроводность плёнок серебра, нанесённых на поверхность стекла и поверхность стекла, предварительно покрытую подслоями германия различной толщины. Ультратонкие плёнки германия (массовая толщина — 0,5–5 нм) ускоряют металлизацию плёнок серебра и уменьшают пороговую толщину перколяционного перехода. Показано, что наибольшие изменения кинетических коэффициентов исследуемых плёнок серебра наблю-

даются в диапазоне толщин подслоя германия, не превышающих 2 нм. Размерные зависимости удельного сопротивления плёнок объяснены в рамках современных модельных представлений о размерных эффектах.

Ключові слова: тонкі металеві плівки, металізувальний підшар, поріг перколяції, розмірний ефект, поверхневе розсіяння носіїв струму, балістичне перенесення заряду.

Key words: thin metal films, percolation threshold, dimensional effect, charge surface scattering, ballistic electronic transport.

Ключевые слова: тонкие плёнки, размерный эффект, поверхностное рассеяние носителей тока, металлизирующий подслой, баллистический перенос заряда.

(Отримано 24 лютого 2017 р.)

### 1. ВСТУП

Плівки шляхетних металів перспективні з точки зору їхнього можливого використання в різних галузях сучасної мікро- та наноелектроніки, зокрема у фотоніці, сенсориці та ін. Ультратонкі плівки металів широко використовуються завдяки можливості зміни в широких межах їхньої структури, електричних та оптичних властивостей, які реалізуються завдяки розробці нових метод формування тонких шарів. Відомо, що пошаровому росту ультратонких металевих шарів на поверхні діелектричних підкладинок перешкоджає коалесценція зародків кристалізації металу, оскільки енергія взаємодії між атомами металу переважає енергію їхньої взаємодії з атомами діелектричної підкладинки. В результаті є порогова товщина d<sub>c</sub>, вище якої у плівці починає проявлятися металічний характер перенесення струму. Величина d<sub>c</sub> для конкретної системи підкладинка-метал залежить від особливостей технології конденсації пари металу на підкладинку. Зниження товщини d<sub>c</sub>, а відповідно, товщини, при якій плівка стає електрично суцільною з металічним характером провідности, можна досягти за допомогою використання поверхнево активних покриттів субатомової товщини, попередньо нанесених на діелектричну підкладинку. Ці покриття протидіють процесам коалесценції зародків кристалізації металу та сприяють формуванню конденсатів, лінійні розміри кристалітів в яких менші за розміри кристалітів у плівках, нанесених на чисту поверхню діелектрика з використанням аналогічної технології препарування плівок. Ця методика зниження d<sub>c</sub> використовувалася в окремих роботах (наприклад, [1-4]), однак відома з літератури інформація про вплив сурфактантних підшарів на структуру й електричні властивості плівок металів недостатня для прогнозування поведінки дуже тонких металевих плівок, одержаних з використанням даної методики.

В роботі досліджено розмірні явища в електропровідності свіжонанесених плівок срібла, сформованих на поверхні отопленого полірованого скла та на поверхні скла, попередньо покритого підшаром ґерманію товщиною в декілька атомних шарів.

# 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Дослідження проводили у відпаяних скляних надвисоковакуумних експериментальних приладах при тиску залишкових газів, не вищому за  $10^{-7}$  Па. Для нанесення плівок використовували метод конденсації пари термічно випаруваного матеріялу. Методика експерименту, яка забезпечувала достатню чистоту препарування плівок, у цілому аналогічна методикам, що використовувались у наших попередніх роботах (наприклад, [3–5]).

Досліджували електропровідність свіжосконденсованих на охолоджені до 78 К підкладинки плівки. Швидкість осадження пари металу не перевищувала 0,01 нм/с, підшар ґерманію товщиною у декілька атомових шарів наносили на підкладинку безпосередньо перед конденсацією срібла. Масову товщину плівок оцінювали за зсувом резонансної частоти п'єзокварцового вібратора з чутливістю, не гіршою за 0,2 нм. Опір плівок вимірювали з допомогою двозондової методики цифровим омметром та фіксували комп'ютером. Опір плівки підшару ґерманію завжди перевищував  $10^8$  Ом.

Плівки срібла дуже сильно піддаються процесам коалесценції, особливо у початковій стадії зародження на поверхні діелектричної підкладинки, а тому виготовлення та вимірювання електрофізичних властивостей плівок срібла проведено при температурі зрідженого азоту.

# 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

На рисунку 1 показано розмірні залежності питомого опору  $\rho$ плівок срібла, нанесених на чисте поліроване скло та скло, покрите підшарами ґерманію різної товщини. З рисунка видно, що при збільшенні товщини підшару ґерманію має місце зсув розмірної залежности  $\rho(d)$  в область менших товщин. Сильна нелінійність ходу розмірної залежности  $\rho(d)$  в області малих товщин обумовлена перколяційним переходом в плівці срібла та характеризується товщиною перколяції  $d_c$ . Згідно з перколяційним моделем [1], порогу протікання струму ('percolation threshold') в плівці відповідає мінімальна товщина плівки  $d_c$ , при якій вини-



Рис. 1. Розмірні залежності питомого опору  $\rho$  свіжонанесених плівок срібла, осаджених на чисту скляну підкладинку (у 0 нм) та підкладинку попередньо покриту підшаром ґерманію (0,5 нм, 1,0 нм, 1,5 нм, 2,0 нм, 3,5 нм, 5,0 нм).<sup>1</sup>



Рис. 2. Залежності  $R = R(d - d_c)$  у логаритмічному масштабі для свіжонанесених плівок срібла при 78 К (чиста скляна підкладинка у 0 нм та підшари ґерманію — 0,5 нм, 1,0 нм, 1,5 нм, 2,0 нм, 3,5 нм, 5,0 нм).<sup>2</sup>

кають перші канали провідности металічного характеру. В околі переходу від острівцевої до електросуцільної плівки залежність опору *R* плівки металу від товщини *d* можна представити деякою універсальною функцією товщини:

$$R(d) \propto (d-d_c)^{-\gamma}.$$
 (1)

Вираз (1) одержано на основі припущення, що  $(d - d_c) \propto (x - x_c)$ , де x — параметр, який характеризує ступінь заповнености підкладинки металом;  $x_c$  — параметр перколяції, який відповідає ступеню заповнености поверхні підкладинки, при якому острівці (кристаліти) сформують перший провідний канал. Показник степеня у виразі (1) залежить від механізму формування та росту плівки. При двовимірному рості плівки (2D-перколяція) величина показника степеня  $\gamma$  лежить в межах від 1 до 1,3, а у випадку 3D-перколяції величина  $\gamma$  звичайно перевищує 1,5. Відповідно ступінь заповнення поверхні кристалітами  $x_c \ge 0,3$  при 2D-перколяції, а для 3D режиму росту  $x_c \ge 0,5$ .

Проаналізуємо дані, наведені на рис. 1, за допомогою виразу (1). З цією метою лінеаризуємо залежності опору плівок від товщин плівки в логаритмічному масштабі шляхом підбору величини  $d_c$ . Графіки таких залежностей подано на рис. 2.

Залежності перколяційних коефіцієнтів  $d_c$  та  $\gamma$  від товщини плівки ґерманію  $d_{\text{Ge}}$  представлено на рис. 3. Аналіза ходу залежностей  $d_c$  та  $\gamma$  від  $d_{\text{Ge}}$  показує, що підшари ґерманію найсильніше впливають на параметри перколяції в діяпазоні товщин підшару ґерманію до 2 нм, де для свіжонанесених плівок срібла, осаджених на чисту скляну поверхню  $d_c = 8,0$  нм та  $\gamma = 1,23$ , а для аналогічних плівок, осаджених на підшари ґерманію товщиною  $d_{\text{Ge}} = 2$  нм,  $d_c = 3,12$  нм та  $\gamma = 1,03$ , в той час як для  $d_{\text{Ge}} = 5$  нм,  $d_c = 2,86$  нм та  $\gamma = 1,02$ . Для товщин підшару ґерманію більших за  $d_{\text{Ge}} = 2$  нм величини перколяційних параметрів майже не зміню-



**Рис. 3.** Залежності перколяційних коефіцієнтів свіжонанесених плівок срібла  $d_c$  та  $\gamma$  від масової товщини плівок ґерманію  $d_{\text{Ge}}$  при 78 К.<sup>3</sup>

ються. Така поведінка може бути зумовлена особливостями формування підшарів ґерманію: кількість активних центрів на поверхні підкладинки із зміною  $d_{\text{Ge}}$  (при  $d_{\text{Ge}} > 2$  нм) не змінюється, оскільки поверхня скляної підкладинки практично повністю покрита атомами Ґерманію.

Кінетичні коефіцієнти досліджуваних плівок товщиною d < 50нм підлягають прояву класичного розмірного ефекту. Тому цікаво здійснити кількісний опис, одержаних експериментальних результатів з використанням існуючих теорій розмірного ефекту.

Оскільки на графіках розмірних залежностей питомого опору плівок побудованих у вигляді  $\rho(d)d = f(d)$  у діяпазоні достатньо великих товщин плівок ( $d > \lambda$ ) існують лінійні ділянки, то згідно з моделем пласкопаралельного шару Фукса-Зондгаймера можна стверджувати, що мікроструктура плівок не змінюється при зміні товщини плівки. Для характеристики ступеня досконалости плівок можна використати величини  $\rho_{\infty}$  ( $\rho_{\infty}$  — питомий опір плівки безмежної товщини  $d \to \infty$ , структура якої ідентична структурі відповідної тонкої плівки) та λ (λ — середня довжина вільного пробігу вільних електронів у плівці даного ступеня досконалости). При переході до квазибалістичного перенесення заряду  $(d \le \lambda)$  опис розмірних залежностей питомого опору необхідно здійснювати на основі теоретичних моделів, які враховують параметри макроскопічних поверхневих неоднорідностей. Найчастіше такий опис здійснюють на основі теорій Намба та Віссмана [2]. Розмірна залежність р від середньої товщини плівки d у теорії Намба в наближенні товстих плівок (d >>  $\lambda$ ) може бути записана як

$$\rho(d) = \rho_{\infty} \left( 1 + (h/d)^2 \right)^{-1/2} \left( 1 + 3\lambda (1-p) \left( 1 + (h/d)^2 \right)^{-1} / 8d \right), \quad (2)$$

а у Віссмановій теорії [7] в першому наближенні —

$$\rho(d) = \rho_{\infty} \left( \frac{1 + 3(1 - p)\lambda}{8d} + \frac{3(1 - p)\lambda H^2}{8d^3} \right),$$
 (3)

де p — коефіцієнт дзеркальности поверхневого відбивання носіїв струму (для дрібнокристалічних плівок p = 0), h — середня амплітуда макроскопічних поверхневих неоднорідностей, а H — максимальна амплітуда макроскопічних поверхневих неоднорідностей. Зауважимо, у Віссмановому моделю передбачається, що поверхневі неоднорідності розподілені за певним симетричним законом розподілу (Ґауссовим чи іншим), зокрема, якщо вважати, що розподіл поверхневих неоднорідностей описується законом синуса або косинуса, тоді є зв'язок між h та H у вигляді  $H = \sqrt{2}$  h. При d >> h обидва вирази трансформуються у відомий вираз



**Рис. 4.** Залежності величин  $\rho_{\infty}$ ,  $\lambda$  та *h* для свіжонанесених плівок срібла від товщини підшарів ґерманію  $d_{\text{Ge}}$  при 78 К, розрахованих згідно (2) та (3).<sup>4</sup>

теорії Фукса-Зондгаймера. Результати розрахунку на основі виразів (2) та (3) параметрів перенесення заряду у плівках, сформованих на поверхні підшарів ґерманію різної масової товщини наведено на рис. 4.

Висновки щодо характеру зміни параметрів перенесення заряду при зміні товщини підшарів ґерманію аналогічні висновкам, зробленим при аналізі рис. З. Лише зауважимо, що, згідно з моделем вільних електронів, між середньою довжиною вільного пробігу  $\lambda$  і питомим опором плівки металу  $\rho_{\infty}$  є взаємозв'язок, який описують виразом:

$$\lambda \rho_{\infty} = \frac{\hbar}{e^2} \left( 3\pi^2 \right)^{1/3} N_c^{-2/3} \approx 12737, 21 N_c^{-2/3}, \qquad (4)$$

де  $\hbar$  — зведена стала Планка, e — заряд електрона та  $N_c$  — концентрація носіїв струму в зразку. Результати розрахунку  $N_c$  для плівок срібла наведено в табл.

З таблиці видно, що розраховані з експериментальних розмірних залежностей питомого опору плівок величини  $N_c$  достатньо близькі до величини  $N_{\rm bulk} = 5,86\cdot 10^{28}$  м<sup>-3</sup> масивного металу, наведеної у [3].

Внесок поверхневого розсіяння носіїв струму в сумарний питомий опір плівки  $\rho(d)$  товщиною d можна врахувати за допомогою поняття залишкової провідности  $\sigma_{res}$ ; тут  $\sigma_{res} = 1/\rho_{res} = 1/(\rho(d) - \rho_{\infty})$ . Величина  $\sigma_{res}$  в області товщин класичного розмірного ефекту  $(d \ge \lambda)$  змінюється із зміною товщини плівки лінійно:  $\sigma_{res} \propto d$ . У

$d_{ m Ge}$	$\rho_\infty \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$	λ, нм	$N_c$ , $10^{28}$ м $^{-3}$
5	12	7,1	5,78
3,5	11,9	7,1	5,85
2	11,6	7,3	5,83
1,5	10,3	8,5	5,55
1	8,1	11	5,40
0,5	5,5	16	5,50
0	2,2	41	5,72
bulk	0,285	296	5,86

**ТАБЛИЦЯ.** Результати розрахунку N<sub>c</sub> для плівок срібла.<sup>5</sup>

плівках, товщина яких задовольняє розмірній умові  $d \leq \lambda$ , спостерігається квазибалістичне перенесення заряду, при якому переважаючим стає розсіяння носіїв струму поверхнею. В діяпазоні товщин  $d_c \leq d \leq \lambda$ , характер зміни залежности  $\sigma_{\rm res}(d)$  змінюється внаслідок впливу розсіяння носіїв струму макроскопічними неоднорідностями поверхні. В режимі прояву балістичного розмірного ефекту ( $d = \lambda$ ) залежність залишкової провідности  $\sigma_{\rm res}$  від товщини описується степеневою залежністю:  $\sigma_{\rm res} \propto d^{\alpha}$  [4], причому величина  $\alpha$  задовольняє нерівності  $2, 1 \leq \alpha \leq 6$ , залежно від особливостей електронної структури зразка.

На рисунку 5 показано розмірні залежності залишкової провідности плівок срібла, сформованих на чистій поверхні скла (крива 1) та на поверхні скла, покритій підшарами ґерманію різної масової товщини (криві 2-7). На графіках чітко видно існування на кожній кривій двох лінійних ділянок з нахилом  $\alpha = 1$  (діяпазон великих товщин  $d >> \lambda$ ) та  $2, 1 \le \alpha \le 6$  (діяпазон товщин d < 10нм). Хід залежности  $\sigma_{res}$  від d у перехідній ділянці товщин можна апроксимувати з допомогою виразів (2) і (3). В діяпазоні малих товщин лінійність  $\sigma_{\rm res}(d) \propto d_{\alpha}$  зберігається до товщин плівок, товщина яких  $d \ge (1,5-2)d_c$ , оскільки саме до цих товщини основним механізмом перенесення заряду у плівках ще є металічний характер провідности. Зауважимо, що у плівках срібла, сформованих на поверхні підшарів ґерманію, ділянка переходу від класичного перенесення заряду ( $\alpha = 1$ ) до балістичного ( $\alpha > 2,1$ ) зсунута в діяпазон менших товщин у порівнянні з даними, наведеними для плівок сформованих на чистій поверхні скла (крива 1). Це підтверджує факт зменшення середньої довжини вільного пробігу носіїв струму  $\lambda$  (узгоджується з даними рис. 4). Зміна кутів нахилу ходу розмірних залежностей о<sub>гез</sub> в діяпазоні класичного балістичного перенесення заряду при змінах товщини підша-



Рис. 5. Розмірні залежності питомої залишкової провідности  $\sigma_{res} = \sigma_{res}(d)$ плівок срібла свіжонанесених на чисту скляну підкладинку (1) та на підкладинку попередньо покриту підшарами ґерманію масовою товщиною 0,5 нм (2), 1,0 нм (3), 1,5 нм (4), 2,0 нм (5), 3,5 нм (6) та 5,0 нм (7). Точки експериментальні дані, відрізки прямих — лінійна апроксимація.<sup>6</sup>

рів ґерманію, свідчить про зміну умов розсіяння носіїв струму поверхневими неоднорідностями (зокрема, про вплив зміни середньої амплітуди макроскопічних неоднорідностей — рис. 4).

З рисунку 6 видно, що найбільш істотні зміни показника степеня α спостерігаються у діяпазоні зміни масової товщини під-



**Рис. 6.** Залежність показника степеня  $\alpha$  від масової товщини підшару ґерманію.<sup>7</sup>

шарів ґерманію від 0 до 2,0 нм. Це також підтверджує, що підшари ґерманію масовою товщиною 2 нм практично повністю блокують вплив поверхні скляної підкладинки на формування плівки металу.

Кількісний опис, одержаних розмірних залежностей провідности плівок срібла, сформованих на поверхні скла та підшарів ґерманію (рис. 1) в широкому діяпазоні товщин неможливо провести на основі теорій класичного (моделі Фукса-Зондгаймера, Віссмана та Намба) та квантового розмірних ефектів [4], оскільки припущення, покладені в основу теорій квантового розмірного ефекту, виключали можливості узгодження з висновками квазикласичних теорій. Зокрема, теорії [4] передбачали існування балістичного перенесення заряду у плівках і ніяким чином не допускали можливости релаксації носіїв струму в об'ємі плівки. На відмінну від згаданих модельних підходів, теорія [5] при розрахунку закономірностей балістичного перенесення заряду, враховувала особливості поступового переходу від квазибалістичного до повністю балістичного перенесення заряду при зменшенні товщини плівки. Завдяки цьому вирази теорії [5] уможливили описати перенесення заряду у плівках міді, золота та інших металів в широкому діяпазоні товщин від (1,5-2,0)d<sub>c</sub> до 40-50 нм. Підстановка у вирази теорії [5] параметрів перенесення заряду (р., та λ), визначених на основі моделю Фукса-Зондгаймера, уможливила забезпечити кількісне узгодження графіків розрахункових за-



Рис. 7. Розмірні залежності питомої провідности  $\sigma = \sigma(d)$  плівок срібла, свіжонанесених на скляну підкладинку, попередньо покриту підшарами ґерманію масовими товщинами у (1) 0,5 нм, (2) 1,5 нм та (3) 5 нм. Точки — експериментальні дані, суцільні криві — теоретична апроксимація [5].<sup>8</sup>

лежностей  $\sigma = \sigma(d)$  з графіками експериментальних залежностей з допомогою використання припасувального параметра  $\Delta h$  (середній відхил локальної неоднорідности поверхні від пласкої поверхні), величина якого близька до характеристик неоднорідностей поверхні, визначених на основі прямого СТМ-дослідження поверхні.

Експериментальні дані, одержані для свіжонанесених плівок срібла, також добре узгоджуються з розрахунковими. Сказане ілюструє рис. 7, на якому точками показано експериментальні величини  $\sigma$  (питомої провідности) плівок срібла сформованих на поверхні підшарів ґерманію масовими товщинами у 0,5 нм, 1,5 нм та 5 нм, а суцільні криві — розрахункові залежності, знайдені на основі виразів теорії [5]. Методику відповідного співставлення достатньо повно описано нами у [1, 2].

### 4. ВИСНОВКИ

1. В умовах надвисокого вакууму при тиску залишкових газів не вищому за  $10^{-7}$  Па досліджено вплив підшарів ґерманію різної масової товщини на розмірні залежності питомого опору (питомої провідности  $\sigma$ ) свіжонанесених при T = 78 К на поверхню цих підшарів плівок срібла.

2. Показано, що використана в роботі методика «замороженої конденсації» пари металу забезпечує формування електрично суцільних шарів металу з розмірами зерна, незалежними від товщини плівки металу.

3. Результати дослідження розмірних залежностей питомої провідности плівок кількісно описано в широкому діяпазоні товщин за допомогою виразів теорії [5].

### ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1. Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, Н. С. Колтун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Металофиз. новейшие технол., 35, № 1: 85 (2013).
- 2. М. Д. Бучковська, Фізика та хімія поверхні, 13, № 4: 916 (2012).
- 3. CRC Handbook of Chemistry and Physics (Ed. D. R. Lide) (Boca Raton, FL: CRC Press: 2005).
- 4. Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, Н. С. Колтун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Металофиз. новейшие технол., 35, № 12: 1659 (2013).
- 5. R. I. Bihun, Z. V. Stasyuk, and O. A. Balitskii, Physica B, 487: 73 (2016).

#### REFERENCES

1. R. I. Bihun, M. D. Buchkovska, N. S. Koltun, Z. V. Stasiuk, and D. S. Leonov,

Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, No. 1: 85 (2013) (in Ukrainian).

- 2. M. D. Buchkovska, Fizyka ta Khimiya Poverkhni, 13, No. 4: 916 (2012) (in Ukrainian).
- CRC Handbook of Chemistry and Physics (Ed. D. R. Lide) (Boca Raton, FL: 3. CRC Press: 2005).
- R. I. Bihun, M. D. Buchkovska, N. S. Koltun, Z. V. Stasiuk, and D. S. Leonov, 4. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, No. 12: 1659 (2013) (in Ukrainian).

5. R. I. Bihun, Z. V. Stasyuk, and O. A. Balitskii, Physica B, 487: 73 (2016).

<sup>1</sup>Ivan Franko National University of Lviv,

<sup>2</sup>Technical Centre, N.A.S. of Ukraine,

<sup>1</sup> Fig. 1. Size dependence of the resistivity  $\rho$  of silver films freshly deposited on a clean glass substrate (of 0 nm) and substrate pre-coated with germanium sublayer (of 0.5 nm, 1.0 nm, 1.5 nm, 2.0 nm, 3.5 nm or 5.0 nm).

<sup>2</sup> Fig. 2. Dependences  $R = R(d - d_c)$  in logarithmic scale for freshly deposited silver films at 78 K (clear glass substrate of 0 nm and Ge sublayers with thicknesses of 0.5 nm, 1.0 nm, 1.5 nm, 2.0 nm, 3.5 nm or 5.0 nm).

<sup>3</sup> Fig. 3. Dependences of percolation coefficients freshly deposited films of silver  $d_c$  and  $\gamma$  on mass thickness of germanium films,  $d_{\text{Ge}}$ , at 78°C.

<sup>4</sup> Fig. 4. Dependences of  $\rho_{\infty}$ ,  $\lambda$  and h for freshly deposited silver films on thickness of Ge sublayers,  $d_{\text{Ge}}$ , at 78 K calculated according to (2) and (3).

<sup>5</sup> **TABLE.** The calculation results for  $N_c$  of silver films.

<sup>6</sup> Fig. 5. Size dependence of specific residual conductivity,  $\sigma_{res} = \sigma_{res}(d)$ , of silver films freshly deposited on a clean glass substrate (1) and substrate pre-coated with germanium sublayers with mass thicknesses of 0.5 nm (2), 1.0 nm (3), 1.5 nm (4), 2.0 nm (5), 3.5 nm (6), and 5.0 nm (7). Dots-experimental data, segments-linear approximation.

<sup>7</sup> Fig. 6. Dependence of the exponent  $\alpha$  on mass thickness of germanium sublayer.

<sup>8</sup> Fig. 7. Size-dependent conductivity  $\sigma = \sigma(d)$  of silver films freshly deposited on glass substrate pre-coated with germanium sublayers with mass thicknesses of (1) 0.5 nm, (2) 1.5 nm, and (3) 5 nm. Dots-experimental data, solid curves-theoretical approximation [5].

<sup>50.</sup> Drahomanov Str.,

UA-79005 Lviv, Ukraine

<sup>13,</sup> Pokrovska Str., UA-04070 Kyyiv, Ukraine